

### Бескорпусной кремниевый высокочастотный р-р-р транзистор малой мощности

Типовое значение граничной частоты передачи тока  $f_{ГР} = 450$  МГц  
 Максимальная рассеиваемая мощность коллектора  $P_{Кмакс} = 120$  мВт  
 Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер  $U_{Кэмакс} = 40$  В

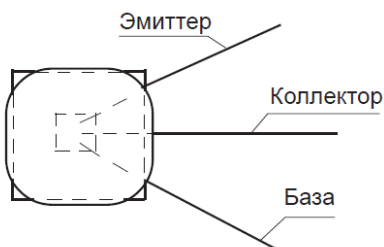
Тип изделия	НомерТУ	Тип корпуса
2Т392А-2	ХМ3.365.022 ТУ	Без корпуса, сопроводительная тара ТС4, ТС16

Бескорпусные на диэлектрической подложке с гибкими выводами и защитным покрытием кремниевые планарно-эпитаксиальные р-р-р высокочастотные усилительные транзисторы 2Т392А-2 предназначены для использования в неремонтируемых гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры.

Маркировка транзисторов соответствует техническим условиям ХМ3.365.022 ТУ.

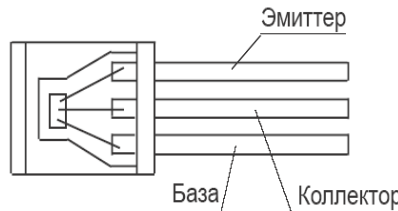
Знаком Н обозначаются изделия повышенной надежности. Размеры кристалла 0,5 x 0,5 мм.

#### Схема расположения выводов

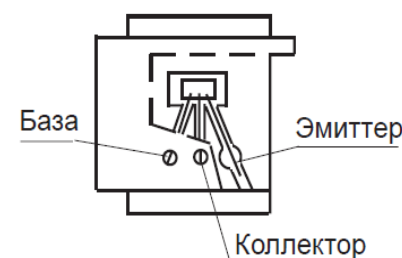


**2Т392А-2**

#### Сопроводительная тара



**ТС4**



**ТС16**

#### Основные электрические параметры при температуре: 0°C ÷ + 70°C

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	2Т392А-2	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора ( $U_{КБ} = 40$ В), мкА	$I_{КБО}$		0,5
Обратный ток эмиттера ( $U_{ЭБ} = 4$ В), мкА	$I_{ЭБО}$		0,5
Статический коэффициент передачи тока ( $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 2,5$ мА, $t_{и} \leq 2$ мс, $f \leq 50$ Гц)	$h_{21Э}$	40	180
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ( $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 2,5$ мА, $f = 100$ МГц)	$ h_{21Э} $	3	
Граничная частота коэффициента передачи тока ( $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 2,5$ мА), МГц	$f_{ГР}$	300	
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ( $U_{КБ} = 5$ В, $I_Э = 2,5$ мА, $f = 30$ МГц), пс	$\tau_K$		120
Емкость коллекторного перехода ( $U_{КБ} = 5$ В, $f = 5$ МГц), пФ	$C_K$		2,5
Емкость эмиттерного перехода ( $U_{ЭБ} = 1$ В, $f = 5$ МГц), пФ	$C_Э$		5
Коэффициент шума ( $I_К = 100$ мА, $I_Б = 1$ мА), дБ	$K_{Ш}$		4,3* - 4,8*

\* - типовое



Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	2Т392А-2	Примечание
Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ\max}$	40	
Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 10 \text{ кОм}$ , В	$U_{КЭ\max}$	40	
Максимально – допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ\max}$	4	
Максимально – допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{К\max}$	10	
Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 10 \text{ мкс}$ , $Q \geq 2$ , мА	$I_{КИ\max}$	20	
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора в условной микросхеме, мВт при $T \leq +65^\circ\text{C}$ при $T = +85^\circ\text{C}$	$P_{К\max}$	120 88	
Тепловое сопротивление переход - кристаллодержатель, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Тп-к}$	100	
Общее тепловое сопротивление, $^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{Тп-с}$	450	
Температура перехода, $^\circ\text{C}$	$T_{п}$	125	

Основные типовые зависимости параметров транзисторов

